

公司代码：688082

公司简称：盛美上海



盛美半导体设备（上海）股份有限公司
2021 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析：四、风险因素”部分内容。

3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

是 否

7 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

充分考虑到公司目前处于发展期，研发项目及经营规模不断扩大，资金需求较大，为更好地维护全体股东的长远利益，保障公司的可持续发展和资金需求，公司2021年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。本议案已经公司第一届董事会第十七次会议审议通过，尚需公司2021年年度股东大会审议。

8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

适用 不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	盛美上海	688082	不适用

公司存托凭证简况

适用 不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	罗明珠	/
办公地址	中国（上海）自由贸易试验区蔡伦路1690号第4幢	/
电话	021-50276506	/
电子信箱	ir@acmrcsh.com	/

2 报告期公司主要业务简介

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

1. 主要业务

公司主要从事半导体专用设备的研发、生产和销售，主要产品包括半导体清洗设备、半导体电镀设备和先进封装湿法设备等。公司坚持差异化竞争和创新的发展战略，通过自主研发的单片兆声波清洗技术、单片槽式组合清洗技术、电镀技术、无应力抛光技术和立式炉管技术等，向全球晶圆制造、先进封装及其他客户提供定制化的设备及工艺解决方案，有效提升客户的生产效率、提升产品良率并降低生产成本。

2. 主要产品

公司经过多年持续的研发投入和技术积累，先后开发了单片清洗、槽式清洗以及单片槽式组合清洗等清洗设备，用于芯片制造的前道铜互连电镀设备、后道先进封装电镀设备，以及用于先进封装的湿法刻蚀设备、涂胶设备、显影设备、去胶设备、无应力抛光设备及立式炉管系列设备等。

(1) 半导体清洗设备

① 单片清洗设备

公司通过自主研发并具有全球知识产权保护的 SAPS 和 TEBO 兆声波清洗技术，解决了兆声波技术在集成电路单片清洗设备上应用时，兆声波能量如何在晶圆上均匀分布及如何实现图形结构无损伤的全球性难题。为实现产能最大化，公司单片清洗设备可根据客户需求配置多个工艺腔体，最高可单台配置 18 腔体，有效提升客户的生产效率。

a. SAPS 兆声波清洗设备，主要适用于平坦晶圆表面和高深宽比通孔结构内清洗

晶圆表面的兆声波能量与晶圆和兆声波发生器之间的距离呈现周期性的变化。在传统的兆声波清洗工艺中，不同工序后应力带来的晶圆翘曲，使得晶圆上不同点到兆声波发生器的距离不同，

因此晶圆上不同位置的兆声波能量也不相同，无法实现兆声波能量在晶圆表面的均匀分布。而且由于硬件位置控制的误差，也会造成兆声波能量在晶圆表面分布的不均匀。

公司自主研发的 SAPS 兆声波技术采用扇形兆声波发生器，通过精确匹配晶圆旋转速度、液膜厚度、兆声波发生器的位置、交变位移及能量等关键工艺参数，通过在工艺中控制兆声波发生器和晶圆之间的半波长范围的相对运动，使晶圆上每一点在工艺时间内接收到的兆声波能量都相同，从而很好的控制了兆声波能量在晶圆表面的均匀分布。

b. TEBO 兆声波清洗设备，主要适用于图形晶圆包括先进 3D 图形结构的清洗

公司自主研发的 TEBO 清洗设备，可适用于 28nm 及以下的图形晶圆清洗，通过一系列快速（频率达到每秒一百万次）的压力变化，使得气泡在受控的温度下保持尺寸和形状振荡，将气泡控制在稳定震荡状态，而不会内爆，从而保持晶圆微结构不被破坏，对晶圆表面图形结构进行无损伤清洗。公司 TEBO 清洗设备，在器件结构从 2D 转换为 3D 的技术转移中，可应用于更为精细的具有 3D 结构的 FinFET、DRAM 和新兴 3D NAND 等产品，以及未来新型纳米器件和量子器件等，在提高客户产品良率方面发挥越来越重要的作用。

②单片槽式组合清洗设备

公司自主研发的具有全球知识产权保护的 Tahoe 清洗设备在单个湿法清洗设备中集成了两个模块：槽式模块和单片模块。Tahoe 清洗设备可被应用于光刻胶去除，刻蚀后清洗，离子注入后清洗，机械抛光后清洗等几十道关键清洗工艺中。Tahoe 清洗设备的清洗效果与工艺适用性可与单片清洗设备相媲美，与此同时，与单片清洗设备相比，还可大幅减少硫酸使用量，帮助客户降低了生产成本又能更好的符合节能减排的政策。该设备已完成客户端验证，进入量产阶段。

③单片背面清洗设备

公司研发的单片背面清洗设备采用伯努利卡盘，应用空气动力学悬浮原理，使用机械手将晶圆送入腔体后，使晶背朝上，晶圆正面朝下，在工艺过程中，精准流量控制的高纯氮气通过卡具下方的气体管路和卡盘表面一圈的环形小孔源源不断地输入晶圆与卡具之间的空隙中。该设备可用于背面金属污染清洗及背面刻蚀等核心工艺。

④前道刷洗设备

采用单片腔体对晶圆正背面依工序清洗，可进行包括晶圆背面刷洗、晶圆边缘刷洗、正背面二流体清洗等清洗工序；设备占地面积小，产能高，稳定性强，多种清洗方式灵活可选。可用于集成电路制造流程中前段至后段各道刷洗工艺。

⑤全自动槽式清洗设备

公司开发的全自动槽式清洗设备广泛应用于集成电路领域和先进封装领域的清洗、刻蚀、光刻胶去除等工艺，采用纯水、碱性药液、酸性药液作为清洗剂，与喷淋、热浸、溢流和鼓泡等清洗方式组合，再配以先进的常压 IPA 干燥技术及先进的低压 IPA 干燥技术，能够同时清洗 50 片晶圆。该设备自动化程度高，设备稳定性好，清洗效率高，金属、材料及颗粒的交叉污染低。该设备主要应用于 40nm 及以上技术节点的几乎所有清洗工艺。

2021 年完成了 14 台槽式清洗机的设计组装和测试工作，其中 10 台已经运到客户端进行产品片的工艺验证和量产。其中包含了两台使用最新研发的低压 IPA 干燥技术和一台 200mm 全自动槽式清洗设备。

（2）半导体电镀设备

公司自主研发的具有全球知识产权保护的电镀设备已获得下游客户的验证，用于后道先进封装的电镀设备已进入市场并获得重复订单。报告期内，已实现客户端设备量产验证并量产：完成 4 台半导体电镀设备，其中，3 台 Ultra ECP map 电镀设备，1 台 Ultra ECP 3d 电镀设备量产验证并进入量产，应用于 28nm，40nm，55nm，65nm 技术节点和 TSV A:R=10:10 工艺。

①前道铜互连电镀铜设备

公司是目前全球少数几家掌握芯片铜互连电镀铜技术核心专利并实现产业化的公司之一。公司自主开发针对 28-14nm 及以下技术节点的 IC 前道铜互连镀铜技术 Ultra ECP map。公司的多阳极局部电镀技术采用新型的电流控制方法，实现不同阳极之间毫秒级别的快速切换，可在超薄籽晶层（5nm）上完成无空穴填充，同时通过对不同阳极的电流调整，在无空穴填充后实现更好的沉积铜膜厚的均匀性，可满足先进工艺的镀铜需求。

②后道先进封装电镀设备

公司在半导体先进封装领域进行差异化开发，解决了在更大电镀液流量下实现平稳电镀的难题，并采用独创的第二阳极电场控制技术更好地控制晶圆平边或缺口区域的膜厚均匀性控制，可以达到更好的片内均匀，实现高电流密度条件下的电镀，凸块产品的各项指标均满足客户要求。在针对高密度封装的电镀领域可以实现 2 μm 超细 RDL 线的电镀以及包括铜、镍、锡、银和金在内的各种金属层电镀。公司自主开发的橡胶环密封专利技术可以实现更好的密封效果，避免电镀液泄露和镀出问题。

（3）半导体抛铜设备

①前道铜互连抛铜设备

公司经过研究发现，使用 SFP 工艺可以对钎表面进行电解氧化，然后再使用稀氢氟酸刻蚀，

可以达到无机械应力情况下很好的钉金属层去除效果，解决了微细铜线及周边介电质材料的破坏难题。该技术可用于 5nm 及 3nm 技术节点以下的铜互连工艺，同时，因为没有机械应力，可以更加容易把超低 K 介电质 ($K < 2$) 与铜线集成，从而提高芯片的运算速度。

②后道先进封装无应力抛铜设备

公司针对先进封装中 3D TSV、2.5D 硅中介层、RDL、HD Fan-out 等金属层平坦化应用，自主研发了具有全球知识产权保护的无应力抛光设备，该设备具有工艺无应力、抛光电化学液可重复使用从而降低耗材成本和工艺环保排放少等特点。

(4) 先进封装湿法设备

公司坚持差异化竞争战略，基于先进的集成电路前端湿法清洗设备的技术，将产品应用拓展至先进封装应用领域。以先进封装的凸块 (bumping) 封装的典型工艺流程为例，在整个工艺流程中涉及的单片湿法设备包括清洗设备、涂胶设备、显影设备、去胶设备、湿法刻蚀设备、无应力抛光设备等。

目前公司在先进封装行业的产品领域已覆盖全部单片湿法设备，产品先后进入封装企业生产线及科研机构，包括长电科技、通富微电、中芯长电、Nepes、华进半导体和中国科学院微电子研究所等知名封装企业和科研院所。

(5) 立式炉管设备

公司研发的立式炉管设备主要由晶圆传输模块，工艺腔体模块，气体分配模块，温度控制模块，尾气处理模块以及软件控制模块所构成，针对不同的应用和工艺需求进行设计制造，首先集中在炉管 LPCVD 设备，再向氧化炉和扩散炉发展，最后逐步进入到炉管 ALD 设备应用。

(二) 主要经营模式

1. 盈利模式

公司作为一家面向国际科技前沿、坚持自主创新的半导体专用设备企业，遵循全球行业惯例，主要从事技术和工艺研发、产品设计和制造，为客户提供设备和工艺解决方案。公司自身几乎不从事零部件加工业务，公司根据对产品的设计，组织零部件外购及外协，在美国、韩国、中国大陆建立了完善的供应链体系，与核心供应商建立了密切的合作关系，保障了对重要零部件的供应。公司通过长期研发积累形成的技术优势，保持较高的产品毛利，进而保持较高比例的研发投入及市场开拓，在报告期内实现了较高的利润率。

2. 研发模式

公司主要采用自主研发的模式。公司研发部门以半导体专用设备国际技术动态、客户需求为

导向，采用差异化竞争的策略，依靠具有丰富经验的国际化研发团队，研发新工艺、新技术，完成技术方案的验证，并在全球主要半导体生产国家及地区申请专利保护，把研发成果快速产业化，取得了一系列的技术创新和突破。此外，公司在韩国组建了专业的研发团队，结合中国上海以及韩国双方研发团队的各自优势，共同研发用于公司产品的差异化相关技术，提升公司产品性能。公司制定了《研发项目管理办法》，对研发项目的立项、审批、执行等流程进行了规定。未来公司将继续吸引国内外的优秀人才，扩大充实公司世界一流的研发团队，为全球客户不断地提供最好的工艺解决方案。

3.采购模式

为保障公司产品质量和性能，公司建立了完善的采购体系，要求供应商填写《供方调查表》，建立供应商档案，了解供应商的人员情况、生产能力、设计能力、财务情况、关键零部件供应商情况、生产和检测设备情况等，对供应商的产品技术与质量、按时交货能力和售后服务等进行综合评估，最终确定合格供应商，纳入合格供应商名单。目前，公司已与主要供应商建立了稳定的长期合作关系。

公司在韩国和美国分别组建了原材料采购团队，并成立了盛美韩国和盛美加州，依靠韩国和美国较为发达和完善的半导体产业链，负责公司部分原材料的境外采购。

4.生产模式

公司产品均为根据客户的差异化需求，进行定制化设计及生产制造，主要采取以销定产的生产模式，按客户订单组织生产。

公司制造部根据市场预测或客户的非约束性预测，编制年度生产计划，并结合客户订单情况编制每月生产计划。公司研发设计工程师根据客户订单提供装配图纸，分发到仓库和生产车间，进行仓库领料、配料和装配，预装配并预检合格后，交由生产线组装，并进行各模块的功能测试，测试合格后，下线发货。公司对外协加工的质量严格把关，与外协厂商建立了多年稳定的合作关系，确保符合客户的差异化需求。

5.销售模式

公司自设立以来，始终坚持全球化发展战略，客户主要位于中国大陆、中国台湾、韩国等国家和地区。公司的市场开拓策略为：首先开拓全球半导体龙头企业客户，通过长时间的研发和技术积累，取得其对公司技术和产品的认可，以树立公司的市场声誉。然后凭借在国际行业取得的业绩和声誉，持续开拓中国大陆等半导体行业新兴区域市场。经过多年的努力，公司已与海力士、长江存储、华虹集团、中芯国际及长电科技等国内外半导体行业龙头企业形成了较为稳定的合作

关系。

公司通过直销模式销售产品，不存在分销和经销模式。报告期内，公司通过委托代理商推广、与潜在客户商务谈判或通过招投标等方式获取订单。

(三) 所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

(1) 行业发展态势与面临的机遇

①半导体应用和消费市场需求长期保持增长

随着中国成为世界电子信息产品最重要的生产基地之一，越来越多的国际半导体企业向中国转移产能，持续的产能转移不仅带动了中国大陆半导体整体产业规模和技术水平的提高，为半导体专用设备制造业提供了巨大的市场空间，也促进了中国半导体产业专业人才的培养及配套行业的发展，半导体产业环境的良性发展为中国半导体专用设备制造业产业的扩张和升级提供了机遇。

据 SEMI 的《全球半导体设备市场统计报告》，2020 年全球半导体设备的销售规模为 712 亿美元，创历史最高，比 2019 年（598 亿美元）增长 19%。据 SEMI 预测，2021 年全球半导体设备销售额将达到 953 亿美元，同比增长 34.1%，预测 2022 年全球半导体设备销售额再增长 11%。

②全球半导体行业区域转移

半导体行业具有生产技术工序多、产品种类多、技术更新换代快、投资高风险大、下游应用广泛等特点，叠加下游新兴应用市场的不断涌现，半导体产业链从集成化到垂直化分工的趋势越来越明确。目前，全球半导体行业正在开始第三次产业转移，即向中国大陆转移。

受益于半导体产业加速向中国大陆转移，中国大陆作为全球最大半导体终端产品消费市场，中国半导体产业的规模不断扩大，随着国际产能不断向中国转移，半导体企业纷纷在中国投资建厂，中国大陆半导体专用设备需求将不断增长。

(2) 半导体专用设备行业特点

①半导体专用设备在半导体产业链中的地位至关重要

半导体专用设备在半导体行业产业链中占据重要的地位。半导体专用设备的技术复杂，客户对设备的技术参数、运行的稳定性有苛刻的要求，以保障生产效率、质量和良率。集成电路制造工艺的技术进步，反过来也会推动半导体专用设备企业不断追求技术革新。同时，集成电路行业的技术更新迭代也带来对于设备投资的持续性需求，而半导体专用设备的技术提升，也推动了集成电路行业的持续快速发展。

②半导体专用设备技术壁垒高，通过客户验证难度大

半导体专用设备行业为技术密集型行业，生产技术涉及微电子、电气、机械、材料、化学工程、流体力学、自动化、图像识别、通讯、软件系统等多学科、多领域知识的综合运用。半导体专用设备行业的国际巨头企业的市场占有率很高，特别是在光刻机、检测设备、离子注入设备等方面处于垄断地位，且其在大部分技术领域已采取了知识产权保护措施，因此半导体专用设备行业的技术壁垒非常高。中国大陆少数企业经过了十年以上的技术研发和工艺积累，在部分领域实现了技术突破和创新，在避免知识产权纠纷的前提下，成功推出了差异化的产品，得到国内外客户的认可，产品走向了国际市场。半导体专用设备价值较高、技术复杂，对下游客户的产品质量和生产效率影响较大。半导体行业客户对半导体专用设备的质量、技术参数、稳定性等有严苛的要求，对新设备供应商的选择也较为慎重。一般选取行业内具有一定市场口碑和市占率的供应商，并对其设备开展周期较长的验证流程。因此，半导体专用设备企业在客户验证、开拓市场方面周期较长、难度较大。

(3) 集成电路设备行业技术门槛高，公司的技术水平与国际巨头仍有差距，需加快技术研发与产业化进程。当今国际先进水平的集成电路设备涉及微电子、电气、机械、材料、化学工程、流体力学、自动化、图像识别、通讯、软件系统等多学科、多领域知识综合运用及动态密封技术、超洁净室技术、微粒及污染分析技术等多种尖端制造技术。因此，集成电路设备具有技术含量高、制造难度大、设备价值高和行业门槛高等特点，被公认为工业界精密制造最高水平的代表之一。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

全球半导体清洗设备市场高度集中，尤其在单片清洗设备领域，DNS、TEL、LAM 与 SEMES 四家公司合计市场占有率达到 90%以上，其中 DNS 市场份额最高，市场占有率在 40%以上。本土 12 英寸晶圆厂清洗设备主要来自 DNS、盛美、LAM、TEL。

目前，中国大陆能提供半导体清洗设备的企业较少，主要包括盛美上海、北方华创、芯源微及至纯科技。公司的 2018 年销售额突破 5 亿元，2020 年销售突破 10 亿元，比 2019 年 7.57 亿元销售额增长 32%，位列全国集成电路设备企业前三；具备了成为国际领先集成电路设备企业的基础和潜力。

根据中银证券专题报告的历年累计数据统计显示，公司清洗设备的国内市占率为 23%；而 Gartner2020 年数据显示，公司在全球清洗设备的市场份额已升至 4%，其中单片、槽式清洗设备的全球市场份额达到 5.2%。除清洗设备外，公司亦积极扩大产品组合，在半导体电镀设备、半导体抛铜设备、先进封装湿法设备、立式炉管设备等领域扩大布局。

2020 年中国大陆半导体专用设备制造五强企业中，公司位列其中。

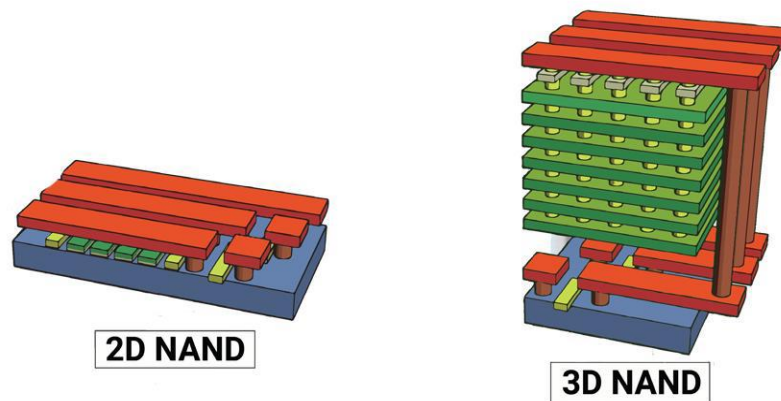
3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

受到国家重大科技专项的推动，我国半导体设备取得重大进展，整体技术水平达到 28nm 制程，在 14nm、7nm、5nm 制程实现了部分设备的突破。当前我国 8 英寸晶圆工艺设备已大部分实现国产化，部分 12 英寸晶圆工艺设备也进入了大生产线使用，或正在进行测试验证。

（1）将向高精密化与高集成化方向发展

随着半导体技术的不断进步，半导体器件集成度不断提高。一方面，芯片工艺节点不断缩小，由 12 μm -0.35 μm （1965 年-1995 年）到 65nm-22nm（2005 年-2015 年），且还在向更先进的方向发展；另一方面半导体晶圆的尺寸却不断扩大，主流晶圆尺寸已经从 4 英寸、6 英寸，发展到现阶段的 8 英寸、12 英寸。此外，半导体器件的结构也趋于复杂。例如存储器领域的 NAND 闪存，根据国际半导体技术路线图预测，当工艺尺寸到达 14nm 后，目前的 Flash 存储技术将会达到尺寸缩小的极限，存储器技术将从二维转向三维架构，进入 3D 时代。3D NAND 制造过程中，主要是将原来 2D NAND 中二维平面横向排列的串联存储单元改为垂直排列，通过增加立体层数，解决平面上难以微缩的工艺问题，堆叠层数也从 32 层、64 层向 128 层发展。这些对半导体专用设备的精密性与稳定性的要求越来越高，未来半导体专用设备将向高精密化与高集成化方向发展。

2D NAND 与 3D NAND 结构示意图



（2）各类技术等级设备并存发展

考虑到半导体芯片的应用极其广泛，不同应用领域对芯片的性能要求及技术参数要求差异较大，如手机使用的 SoC 逻辑芯片，往往需要使用 12 英寸晶圆、7nm 的先进工艺，而对于工业、汽车电子、电力电子用途的芯片，仍在大量使用 6 英寸和 8 英寸晶圆及 μm 级工艺。不同技术等级的芯片需求大量并存，这也决定了不同技术等级的半导体专用设备均存在市场需求。未来随着半导体产业技术的持续发展，适用于 12 英寸晶圆以及更先进工艺的半导体专用设备需求将以更快

的速度成长，但高、中、低各类技术等级的设备均有其对应的市场空间，短期内将持续并存发展。

(3) 研发新工艺和设备

完成双大马士革电镀工艺 14nm 变速入水工艺开发，并通过客户 DEMO 获得验证，匹配产线 BSL 数据。完成 3D TSV 工艺高深宽比>10:1 电镀工艺开发。完成 Ultra ECP map+ 14nm 应用设备和工艺技术规格制定，完成 Ultra ECP map++ 7nm 应用设备和工艺技术规格制定。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2021年	2020年	本年比上年 增减(%)	2019年
总资产	6,337,413,410.30	1,843,523,679.83	243.77	1,308,001,477.00
归属于上市公司股东的净资产	4,814,961,103.13	1,048,673,323.85	359.15	829,928,991.74
营业收入	1,620,869,141.67	1,007,471,809.80	60.88	756,732,956.80
归属于上市公司股东的净利润	266,248,156.63	196,769,941.64	35.31	134,887,342.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	194,734,275.20	92,437,799.49	110.67	130,475,035.24
经营活动产生的现金流量净额	-189,182,778.11	-88,244,945.02	不适用	72,706,488.05
加权平均净资产收益率(%)	18.09	21.20	减少3.11个百分点	34.22
基本每股收益(元/股)	0.68	0.50	36.00	0.36
稀释每股收益(元/股)	0.67	0.50	34.00	0.36
研发投入占营业收入的比例(%)	17.18	13.97	增加3.21个百分点	13.12

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	275,223,279.06	350,057,493.29	462,402,876.34	533,185,492.98
归属于上市公司股东的净利润	37,697,336.27	51,978,644.21	59,050,167.92	117,522,008.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	31,453,875.38	17,402,738.81	46,634,406.67	99,243,254.34
经营活动产生的现金流量净额	85,239,915.32	-44,307,788.95	3,303,525.43	-233,418,429.91

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4 股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)								7,054
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)								7,377
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)								
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)								
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)								
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)								
前十名股东持股情况								
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	包含转融通 借出股份的 限售股份数 量	质押、标记 或冻结情 况		股 东 性 质
						股 份 状 态	数 量	

ACM RESEARCH, INC.	0	357,692,308	82.50	357,692,308	357,692,308	无		境外法人
芯维(上海)管理咨询合伙企业(有限合伙)	0	4,756,154	1.10	4,756,154	4,756,154	无		其他
上海浦东新兴产业投资有限公司	0	4,615,384	1.06	4,615,384	4,615,384	无		国有法人
上海集成电路产业投资基金股份有限公司	0	4,615,384	1.06	4,615,384	4,615,384	无		国有法人
中金财富证券—招商银行—中金财富盛美半导体员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	3,219,198	3,219,198	0.74	3,219,198	3,219,198	无		其他
嘉兴海通旭初股权投资基金合伙企业(有限合伙)	0	2,307,692	0.53	2,307,692	2,307,692	无		其他
尚融创新(宁波)股权投资中心(有限合伙)	0	2,076,924	0.48	2,076,924	2,076,924	无		其他
无锡国联产业投资有限公司—江苏惠泉太湖国联新兴成长产业投资企业(有限合伙)	0	1,923,077	0.44	1,923,077	1,923,077	无		其他
上海金浦智能科技投资管理有限公司—上海金浦临港智能科技股权投资基金合伙企业(有限合伙)	0	1,923,077	0.44	1,923,077	1,923,077	无		其他

芯时（上海）管理咨询合伙企业（有限合伙）	0	1,781,923	0.41	1,781,923	1,781,923	无	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明			上海浦东新兴产业投资有限公司持有上海集成电路产业投资基金股份有限公司 7.02%的股份，上海集成电路产业投资基金股份有限公司和上海浦东新兴产业投资有限公司均持有公司 1.06%的股份。除此之外，公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动关系。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			不适用				

存托凭证持有人情况

适用 不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

适用 不适用

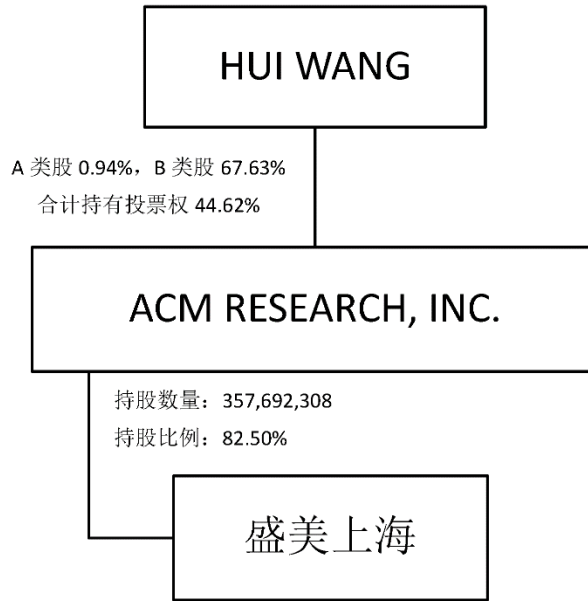
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

5 公司债券情况

适用 不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入 16.21 亿元，较上年同期增长 60.88%；归属于上市公司股东的净利润为 2.66 亿元，较上年同期增长 35.31%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 1.95 亿元，较上年同期增长 110.67 %。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

适用 不适用